

名称: 无锡中微腾芯电子有限公司

地址: 江苏省滨湖区惠河路 5 号

序号	产品/产品类别	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	测量容量	备注
		序号	名称				
1	IC (MOS 随机存储器)	1	全“0”全“1”功能测试	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流: -200mA~200mA 最大 512 通道		
		2	校验板功能测试	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流: -200mA~200mA 最大 512 通道		
		3	输出高电平电压 V_{OH}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流: -200mA~200mA 最大 512 通道		
		4	输出低电平电压 V_{OL}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流: -200mA~200mA 最大 512 通道		
		5	输入负载电流 I_{LI}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流: -200mA~200mA 最大 512 通道		
		6	工作状态电源电流 I_{CC}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流: -200mA~200mA 最大 512 通道		
		7	维持状态电源电流 I_{CCS}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流: -200mA~200mA 最大 512 通道		

2	IC (电压调整器)	1	输出电压 V_o	半导体集成电路电压调整测试方法 GB/T 4377-2018	只测电压-40V~40V 电流: -1A~1A 最大 48 通道		
		2	电压调整率 S_v	半导体集成电路电压调整测试方法 GB/T 4377-2018	只测电压-40V~40V 电流: -1A~1A 最大 48 通道		
		3	电流调整率 S_i	半导体集成电路电压调整测试方法 GB/T 4377-2018	只测电压-40V~40V 电流: -1A~1A 最大 48 通道		
3	IC (模拟开关)	1	模拟开关工作范围 V_A	半导体集成电路模拟开关测试方法 GB/T 14028-2018	只测电压-40V~40V 电流: -1A~1A 最大 48 通道		
4	IC (DC-DC 变换器)	1	输出电压 V_o	混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法 SJ 20646-1997	只测电压-40V~40V 电流: -1A~1A 最大 48 通道		
		2	输出电流 I_o	混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法 SJ 20646-1997	只测电压-40V~40V 电流: -1A~1A 最大 48 通道		
		3	电压调整率 S_v	混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法 SJ 20646-1997	只测电压-40V~40V 电流: -1A~1A 最大 48 通道		
		4	电流调整率 S_i	混合集成电路 DC/DC 变换器测试方法 SJ 20646-1997	只测电压-40V~40V 电流: -1A~1A 最大 48 通道		
5	IC (微处理器)	1	输入高电平电流 I_{IH}	半导体集成电路 第 2 部分: 数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流: -200mA~200mA 最大 512 通道		

		2	输入低电平电流 I_{IL}	半导体集成电路 第 2 部分：数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流：-200mA~200mA 最大 512 通道		
		3	静态工作电流 I_{SB}	半导体集成电路 第 2 部分：数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流：-200mA~200mA 最大 512 通道		
		4	动态工作电流 I_A	半导体集成电路 第 2 部分：数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流：-200mA~200mA 最大 512 通道		
		5	功能测试 test	半导体集成电路 第 2 部分：数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流：-200mA~200mA 最大 512 通道		
		6	输出高电平电压 V_{OH}	半导体集成电路 第 2 部分：数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流：-200mA~200mA 最大 512 通道		
		7	输出低电平电压 V_{OL}	半导体集成电路 第 2 部分：数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流：-200mA~200mA 最大 512 通道		
		8	输入高电平电压 V_{IH}	半导体集成电路 第 2 部分：数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流：-200mA~200mA 最大 512 通道		
		9	输入低电平电压 V_{IL}	半导体集成电路 第 2 部分：数字集成电路 GB/T 17574-1998	只测电压-1V~6V 电流：-200mA~200mA 最大 512 通道		
6	电阻（固定电阻器、金属膜电阻器、薄膜电阻器、线绕电阻器、电	1	标称阻值	电子设备用固定电阻器 第 1 部分：总规范 GB/T 5729-2003	只测： 阻值范围：0.00001 Ω ~99.9999M Ω	0.00001 Ω ~99.9999M Ω	

		2	终端电阻	电子设备用电位器 第1部分：总规范 GB/T 15298-1994	只测： 阻值范围：0.00001 Ω ~99.9999M Ω	0.00001 Ω~99.9999M Ω	
7	二极管（稳压二极管、开关二极管、整流二极管、肖特基二极管、瞬态抑制二极管、发光二极管、硅功率开关二极管）	1	正向电压	半导体器件分立器件和集成电路 第2部分：整流二极管 GB/T 4023-2015	只用脉冲法 只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		2	反向电流	半导体器件分立器件和集成电路 第2部分：整流二极管 GB/T 4023-2015	只用直流法 只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		3	击穿电压	半导体器件分立器件和集成电路 第2部分：整流二极管 GB/T 4023-2015	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		4	工作电压	半导体分立器件 第3部分：信号（包括开关）和调整二极管 GB/T 6571-1995	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		5	微分电阻	半导体分立器件 第3部分：信号（包括开关）和调整二极管 GB/T 6571-1995	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
8	三极管（开关三极管、功率三极管）	1	集电极-基极击穿电压	半导体分立器件和集成电路 第七部分：双极型晶体管 GB/T 4587-1994	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		2	发射极-基极击穿电压	半导体分立器件和集成电路 第七部分：双极型晶体管 GB/T 4587-1994	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		3	集电极-基极截止电流	半导体分立器件和集成电路 第七部分：双极型晶体管 GB/T 4587-1994	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	

		4	集电极-发射极饱和电压	半导体分立器件和集成电路 第七部分：双极型晶体管 GB/T 4587-1994	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		5	发射极-基极截止电流	半导体分立器件和集成电路 第七部分：双极型晶体管 GB/T 4587-1994	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		6	集电极-发射极截止电流	半导体分立器件和集成电路 第七部分：双极型晶体管 GB/T 4587-1994	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		7	共发射极正向电流传输比	半导体分立器件和集成电路 第七部分：双极型晶体管 GB/T4587-1994	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
9	场效应管（结型场效应管、绝缘栅型场效应管）	1	漏源击穿电压	半导体分立器件试验方法 第3部分 试验方法 3000 到 3999 MIL-STD-750-3-2019 方法 3407.1	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		2	阈值电压	半导体器件 分立器件 第8部分：场效应晶体管 GB/T 4586-1994 第IV章第6条	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		3	栅极截止电流	半导体器件 分立器件 第8部分：场效应晶体管 GB/T 4586-1994 第IV章第2条	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		4	漏极电流	半导体器件 分立器件 第8部分：场效应晶体管 GB/T 4586-1994 第IV章第3条	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	
		5	通态漏源电阻	半导体器件 分立器件 第8部分：场效应晶体管 GB/T 4586-1994 第IV章第16条	只测：电压范围： 0V~2000V， 电流范围：0A~200A	电压范围：0V~2000V， 电流范围：0A~200A	

10	AECQ-100 集成电路试验	1	预处理	非密封表面贴装器件的湿度/回流焊敏感度分级 JEDEC J-STD-020F-2022	仅针对塑封器件	温度: 25°C-150°C; 湿度: 30%RH-98%RH 回流焊温度: 25°C -300°C	
				非密封表贴器件可靠性试验前 预处理 JEDEC JESD22-A113I-2020			
		2	带偏置稳态湿热	带偏置稳态湿热寿命试验 JEDEC JESD22-A101D.01-2021	只测: 条件范围 温度: 25°C-150°C; 湿度: 30%RH-98%RH	温度: 25°C-150°C; 湿度: 30%RH-98%RH	
		3	带偏置高加速温湿度应力试验	高加速湿热应力试验 JEDEC JESD22-A110E.01-2021	只测: 条件范围 温度: 105-150°C; 湿度: 65%-100%RH	温度: 105°C-150°C; 湿度: 65%-100%RH	
		4	高压蒸煮	加速湿度抵抗-无偏置高压蒸煮 JEDEC JESD22-A102E-2015	只测: 条件范围 温度: 100-134°C; 湿度: 100%RH	温度: 100°C-134°C, 湿度: 100%RH	
		5	无偏置高加速温湿度应力试验	加速湿度抵抗-无偏置高加速温湿度应力试验 JEDEC JESD22-A118B.01-2021	只测: 条件范围 温度: 105°C-150°C; 湿度: 65%-100%RH	温度: 105°C-150°C; 湿度: 65%-100%RH	
		6	无偏置高加速温湿度应力试验	带偏置稳态湿热寿命试验 JEDEC JESD22-A101D.01-2021	只测: 条件范围 温度: 25°C-150°C; 湿度: 30%RH-98%RH	温度: 25°C-150°C; 湿度: 30%RH-98%RH	
		7	温度循环	温度循环 JEDEC JESD22-A104F.01-2023	只测: 条件范围 温度范围: -65°C -150°C	温度范围: -65-150°C	
8	高温贮存寿命	高温存储寿命 JEDEC JESD22-A103E.01-2021	只做条件 A、B、C、D	温度范围: 25°C-150°C			

		9	高温工作寿命	温度、偏置和工作寿命 JEDEC JESD22-A108G-2022	只测温度范围：25℃ -150℃	温度范围：25℃-150℃	
		10	早期寿命失效率	早期寿命失效率 AEC-Q100-008A-2003	只测温度范围：25℃ -150℃	温度范围：25℃-150℃	
		11	非易失性 存储器数据 擦写保持	非易失存储器程序/擦除耐久性，数据保持和可操作寿命试验 AEC-Q100-005D1-2012	只测温度范围：25℃ -150℃	温度范围：25℃-150℃	
		12	邦线剪切	引线邦定剪切试验 AEC-Q100-001C-1998	全尺寸	剪切力≤100kg	
		13	邦线拉力	微电子器件试验方法 MIL-STD-883L-2019 方法 2011.10	只做条件 C、D 只测：拉力≤100g	拉力≤100g	
		14	可焊性	元器件引脚，焊端，焊片，端子和导线可焊性试验 J-STD-002E-2017	仅限浸焊和回流焊	温度范围 25℃-350℃	
		15	物理尺寸	物理尺寸测量 JEDEC JESD22-B100B-2003	尺寸≤400mm	精度：0.0001mm	
		16	锡球剪切	锡球剪切试验 AEC-Q100-010A-2003	全尺寸	剪切力≤100kg	
		17	引脚完整性	引脚完整性 JESD22-B105E-2017	只做条件 A、B	拉力≤4Kg	

		18	机械冲击	机械振动-器件和组件 JEDEC JESD22-B110B.01-2019	只做条件 A、B、F	加速度 \leq 5000g	
		19	变频振动	变频振动 JEDEC JESD22-B103B.01-2016	只做扫频振动条件 1	频率范围: 5HZ~2000HZ 加速度 \leq 50g	
		20	恒定加速度 试验	微电子器件试验方法 MIL-STD-883L-2019 方法 2001.4	只做条件 A-E	加速度 \leq 50000g	
		21	密封试验	微电子器件试验方法 MIL-STD-883L-2019 方法 1014.17	仅做试验条件 A、C	细检漏: 示踪气体氦 (He) 粗检漏: 碳氟化合物	
		22	芯片剪切	微电子器件试验方法 MIL-STD-883L-2019 方法 2019.10	全尺寸	剪切力 \leq 100kg	
11	AECQ-101 分立器件试验	1	预处理	非密封表贴器件可靠性试验前 预处理 JEDEC JESD22-A113I-2020	仅针对塑封器件	温度: 25 $^{\circ}$ C-150 $^{\circ}$ C; 湿度: 30%RH-98%RH 回流焊温度: 25 $^{\circ}$ C -300 $^{\circ}$ C	
				非密封表面贴装器件的湿度/回流焊敏感度分级 JEDEC J-STD-020F-2022			
		2	目检	外观目检 JEDEC JESD22-B101D-2022	放大倍数: 7.5~100 倍	放大倍数: 7.5~100 倍	
3	高温反偏试验	半导体分立器件试验方法 第 2 部分 MIL-STD-750-1A-2016 方法 1038.5、1039.4	针对条件 A	电压 \leq 1500V 温度: 25~175 $^{\circ}$ C			

		4	高温栅偏试验	温度、偏置和工作寿命 JEDEC JESD22-A108G-2022	只测：条件范围 电压≤1500V 温度：25~175℃	电压≤1500V 温度：25~175℃	
		5	温度循环	温度循环 JEDEC JESD22-A104F.01-2023	只测：条件范围 温度范围：-65℃ -150℃	温度范围：-65℃-150℃	
		6	无偏置高加速压力 试验	加速湿度抵抗-无偏置高加速温湿度应力试验 JEDEC JESD22-A118B.01-2021	只测：条件范围 温度：105-150℃； 湿度：65%-100%RH	温度：105℃-150℃； 湿度：65%-100%RH	
		7	高加速应力试验	带偏置高加速温湿度应力试验 JEDEC JESD22-A110E.01-2021	只测：条件范围 温度：105-150℃； 湿度：65%-100%RH	温度：105℃-150℃； 湿度：65%-100%RH	
		8	高温高湿反向偏压	带偏置稳态湿热寿命试验 JEDEC JESD22-A101D.01-2021	只测：条件范围 温度：25℃-150℃； 湿度：30%RH-98%RH	温度：25℃-150℃； 湿度：30%RH-98%RH	
		9	间歇寿命试验	半导体分立器件试验方法 第1部分 MIL-STD-750-1A-2016 方法 1037.3	仅针对无散热条件	功率≤10W	
		10	物理尺寸	物理尺寸测量 JEDEC JESD22-B100B-2003	尺寸≤400mm	精度：0.0001mm	
		11	引出端强度	半导体分立器件试验方法 第2部分 MIL-STD-750-2A-2018 方法 2036.5	只做条件 A、E	拉力≤4Kg	
		12	耐溶剂性	印记持久性 JEDEC JESD22-B107D-2011	只做油墨打标	混合溶剂 1：纯异丙醇 75号航空汽油 混合溶剂 2：松节油 混合溶剂 3：去离子水、	

		13	恒定加速度	半导体分立器件试验方法 第 2 部分 MIL-STD-750-2A-2018 方法 2006.2	只做条件 A-E	加速度 \leq 50000g	
		14	变频振动	变频振动 JEDEC JESD22-B103B.01-2016	只做扫频振动条件 1	频率范围: 5HZ~2000HZ 加速度 \leq 50g	
		15	机械冲击	机械振动-器件和组件 JEDEC JESD22-B110B.01-2019	只做条件 A、B、F	加速度 \leq 50000g	
		16	密封试验	密封 JEDEC JESD22-A109B-2011	仅做试验条件 A、C	细检漏: 示踪气体氦 (He) 粗检漏: 碳氟化合物	
		17	耐焊接热	安装在单面板底面的小型表贴固态器件耐浸焊能力的评估流程 JEDEC JESD22-A111B-2018	仅做浸焊及回流焊	最高温度 \leq 350℃	
				通孔安装器件的耐焊接冲击 JEDEC JESD22-B106E-2016	仅做浸焊及回流焊	最高温度 \leq 350℃	
		18	可焊性	元器件引脚, 焊端, 焊片, 端子和导线可焊性试验 J-STD-002E-2017	仅限浸焊和回流焊	温度范围 25℃-350℃	
		19	邦线拉力	半导体分立器件试验方法 第 2 部分 MIL-STD-750-2A-2018 方法 2037.1	全部条件	拉力 \leq 100g	
		20	邦线剪切	引线邦定剪切试验 AEC-Q101-003A-2005	全尺寸	剪切力 \leq 100kg	
		21	晶片剪切	半导体分立器件试验方法 第 2 部分 MIL-STD-750-2A-2018 方法 2017.3	全尺寸	剪切力 \leq 100kg	